

PNP 三重拡散形シリコントランジスタ

高速度高耐圧スイッチング用

PNP Silicon Triple Diffused Transistor
High Speed High Voltage Switching

特 徴

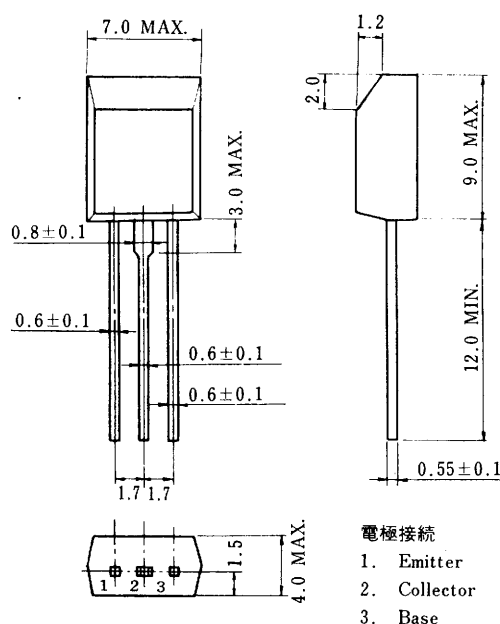
- 高耐圧です。 $V_{CEO} = -400\text{ V}$
- スイッチングスピードが速い。 $t_f < 0.7\text{ }\mu\text{s}$

絶対最大定格 ($T_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-400	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-400	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-7	V
コレクタ電流(直 流)	$I_{C(DC)}$	-2.0	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	-4.0	A
全 損 失	P_T	1.0	W
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

*PW ≤ 10 ms, Duty Cycle ≤ 50 %

外形図 (単位: mm)



電気的特性 ($T_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしや断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -400\text{ V}, I_E = 0$			-10	μA
エミッタしや断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5.0\text{ V}, I_C = 0$			-10	μA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1} *	$V_{CE} = -5.0\text{ V}, I_C = -0.1\text{ A}$	40	60	120	—
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2} *	$V_{CE} = -5.0\text{ V}, I_C = -1.0\text{ A}$	6	22		—
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ *	$I_C = -0.5\text{ A}, I_B = -0.1\text{ A}$		-0.25	-0.5	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$ *	$I_C = -0.5\text{ A}, I_B = -0.1\text{ A}$		-0.85	-1.2	V
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10\text{ V}, I_E = 0, f = 1.0\text{ MHz}$		30	40	pF
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = -10\text{ V}, I_C = -0.1\text{ A}$	10	40		MHz
ターンオン時間	t_{on}	$I_C = -1.0\text{ A}, R_L = 150\text{ }\Omega$		0.03	0.5	μs
蓄 積 時 間	t_{stg}	$I_{B1} = -I_{B2} = -0.2\text{ A}$		1.4	2.0	μs
下 降 時 間	t_f	$V_{CC} = -150\text{ V}$		0.1	0.7	μs

*パルス測定 PW ≤ 350 μs , Duty Cycle ≤ 2 %

h_{FE} 規格区分

捺 印	L	K
h_{FE1}	40 ~ 80	60 ~ 120

特性曲線 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

